

## POLITECHNIKA WARSZAWSKA



## WYDZIAŁ FIZYKI

## PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

WŁASNOŚCI TRANSPORTOWE POJEDYNCZYCH I WIELOKROTNYCH WARSTW GRAFENOWYCH

Autor: Krzysztof GIBASIEWICZ

Promotor: dr inż. Jarosław JUDEK

Warszawa, 31 lipca 2013

DEDYKACJA

This book is dedicated to one of the greatest mathematicians of all time: Carl Friedrich Gauss. Without him, this book wouldn't have been possible.

## SPIS TREŚCI

De	edyka	ıcja	i
Sp	ois tre	eści – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	ii
W	stęp		iv
1	Gre	fen	1
	1.1	Struktura atomowa i własności mechaniczne	1
	1.2	Struktura i własności elektroniczne	1
	1.3	Grafen otrzymywany metodą CVD	1
		1.3.1 Opis metody	1
		1.3.2 Badania strukturalne grafenu	1
	1.4	Zastosowania	1
2	Trar	nzystor FET z kanałem grafenowym	2
	2.1	Tradycyjny tranzystor FET z izolowaną bramką	2
	2.2	Tranzystor FET z kanałem grafenowym	2
	2.3	Proces produkcji tranzystorów z kanałem grafenowym	2
		2.3.1 Struktury tranzystorów	2
		2.3.2 Metoda produkcji tranzystorów	2
3	Pon	niary elektryczne tranzystorów	3
	3.1	Charakterystyki przejściowe i wyjściowe	3
	3.2	Proces wygrzewania prądowego tranzystorów grafenowych	3
	3.3	Ewolucja charakterystyk elektrycznych tranzystorów grafenowych wysta-	
		wionych na działanie atmosfery	3
4	Pod	sumowanie	4

SPIS TREŚCI	iii
Spis tablic	5
Spis rysunków	6
Bibliografia	7

	WSTĘP
	VVO 1 I,1

Tutaj mają być jakieś słodkie ładne rzeczy o tym jaki to ten grafen jest super i jak ładnie zrewolucjonizuje elektronikę i ją zmniejszy żeby spełnione było prawo Moora.

ROZDZIAŁ 1	
l	
	GREFEN

- 1.1 Struktura atomowa i własności mechaniczne
- 1.2 Struktura i własności elektroniczne
- 1.3 Grafen otrzymywany metodą CVD
- 1.3.1 Opis metody
- 1.3.2 Badania strukturalne grafenu
- 1.4 Zastosowania

ROZDZI	AŁ 2
1	
	TRANZYSTOR FET Z KANAŁEM GRAFENOWYM

- 2.1 Tradycyjny tranzystor FET z izolowaną bramką
- 2.2 Tranzystor FET z kanałem grafenowym
- 2.3 Proces produkcji tranzystorów z kanałem grafenowym
- 2.3.1 Struktury tranzystorów
- 2.3.2 Metoda produkcji tranzystorów

Opis metodologii

Zdjęcia optyczne

ROZDZIAŁ 3	3
I	
	POMIARY ELEKTRYCZNE TRANZYSTORÓW

- 3.1 Charakterystyki przejściowe i wyjściowe
- 3.2 Proces wygrzewania prądowego tranzystorów grafenowych
- 3.3 Ewolucja charakterystyk elektrycznych tranzystorów grafenowych wystawionych na działanie atmosfery

ROZDZIAŁ 4	
	PODSUMOWANIE

SPIS TABLIC

<u>,</u>
SPIS RYSUNKÓW
SFIS HISUNNOW

BIBLIOGRAFIA

D.E. Knuth. Typesetting concrete mathematics. *TUGboat*, 10(1):31–36, April 1989.